

Ур-ния (3) содержат 6 независимых скалярных кинетич. коэф., зависящих от магн. поля  $H$ :  $\sigma$ ,  $\chi$ ,  $\alpha$ , а также  $R$ ,  $A_{\text{из}}$ ,  $A_{\text{мл}}$ —коэф., характеризующие эффекты Холла, Нернста—Эттингхазена и Риги—Ледюка—эффект.

В металлах и вырожденных полупроводниках перенос заряда и тепла осуществляется носителями заряда с энергиями вблизи энергии Ферми  $E_F$  в узком слое  $kT$ . Поэтому величины всех коэф. малы, порядка  $kT/E_F$ . В полупроводниках с двумя сортами носителей заряда (электронами и дырками) существенный вклад в Т. я. вносит биполярное движение электронов и дырок, поэтому все кинетич. коэф. Т. я. содержат составляющую, пропорц.  $\delta_g/kT$ , где  $\delta_g$ —ширина запрещённой зоны полупроводника, и, т. о., все коэф. в (3) возрастают.

Обычно с помощью (3) Т. я. в изотропном проводнике классифицируются след. образом: ось  $z$  выбирают вдоль  $H$  и различают продольные ( $j_x=j_y=0$ ,  $q_x=q_y=0$ ) и поперечные ( $j_z=0$ ,  $E_z=0$ ,  $\nabla_z T=0$ ) эффекты. При этом Т. я. подразделяются на изотермические ( $V_y T=0$ ) и адиабатические ( $q_y=0$ ; см. табл.).

#### Поперечные термогальваномагнитные явления (и—изотермические, а—адиабатические)

	Коэф., характеризующие явление	Условия наблюдения	Измеряемая величина
Электропроводность (и, а)	$\sigma = j_x/E_x$	$V_x T=0$ $j_y=0$	$E_x$
Теплопроводность (и, а)	$\chi = -q_x V_x T$	$j_x=j_y=0$	$q_x$
Магнетотермоэлектрический эффект (и, а)	$\gamma = E_x/\nabla_x T$ $R = E_y/Hj_x$	$\nabla_x T=0$ $j_y=0$	$E_x$ $E_y$
Эффект Холла (и, а)			
Эффект Нернста—Эттингхазена (и, а)	$A_{\text{НР}} = E_y/HV_x T$	$j_x=j_y$	$E_y$
Эффект Эттингхазена (а)	$A_s = V_y T/Hj_x$	$\nabla T_x=0$ $j_y=0$	$\nabla_y T$
Эффект Риги—Ледюка (а)	$A_{\text{РЛ}} = V_y T/HV_x T$	$j_x=j_y=0$	$\nabla_y T$

Коэф.  $A_{\text{НР}}$  и  $A_s$  характеризуют соответственно Риги—Ледюка эффект и Эттингхазена эффект.

Указанные в табл. кинетич. коэф. связаны между собой соотношениями

$$\begin{aligned} A_3 &= TA_{\text{НР}}^a \chi^a; \chi^a - \chi^u = H(\chi^u)^2 A_{\text{РЛ}}^2; \\ (\sigma^{-1})^a - (\sigma^{-1})^u &= H^2 A_{\text{НР}}^a A_3; R^u - R^a = \alpha^a A_3; \\ A_{\text{НР}}^a - A_{\text{НР}}^u &= \alpha^a A_{\text{РЛ}}; \chi^a - \chi^u = A_{\text{НР}}^a A_{\text{РЛ}} H^2 / \chi^u. \end{aligned}$$

По определению, эффекты Эттингхазена и Риги—Ледюка могут быть только адиабатическими, остальные Т. я. могут быть как изотермическими, так и адиабатическими. Обычно измерения коэф. Т. я. выполняются в калориметрич. приборах, когда условия эксперимента близки к адиабатическим. Однако если фононная часть теплопроводности значительно больше электронной, то адиабатич. коэф. практически совпадают с изотермическими.

Коэф., характеризующие Т. я., зависят от механизма рассеяния носителей заряда и чувствительны к зависимости времени релаксации импульса т. н. носителей заряда (времени свободного пробега) от их энергии. Кроме того, на эти коэф. влияют зонная структура энергетич. спектра носителей заряда (см. Зонная теория), форма ферми-поверхности, увлечение электронов фононами, тип примесей и т. д. Зависимость коэф. Т. я. от  $H$  определяется параметром  $\omega_c t$ , где  $\omega_c = eH/mc$ —циклотронная частота носителей заряда ( $m$ —их эф. масса). В случае т. н. слабых магн. полей ( $\omega_c t \ll 1$ ) все коэф. не зависят от  $H$ .

Практич. применение Т. я. основано на использовании Пельтье эффекта для охлаждения приборов и устройств, помещённых в сильное магн. поле. Это может приводить к значит. увеличению термоэлектрич. эффективности  $Z = \alpha^2 \sigma$  за счёт роста в магн. поле коэф. термоэлс  $\alpha$  при неизменном значении отношения  $\sigma/\chi$  (в магн. поле выполняется Видемана—Франца закон).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Электродинамика сплошных сред, 2 изд., М., 1982; Цицильковский И. М., Термомагнитные явления в полупроводниках, М., 1960; Блатт Ф., Физика электронной проводимости в твёрдых телах, пер. с англ., М., 1971; Зеегер К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Аскеров Б. М., Электронные явления переноса в полупроводниках, М., 1985; Гуревич Ю. Г., Парадоксы теплопроводности в полупроводниках, «Природа», 1986, № 3, с. 66. А. Э. Майерович.

**ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ**—методы исследования адсорбционно-десорбционных процессов на поверхности твёрдого тела, помещённого в вакуумную камеру, путём измерения в ней давления газа или потока нейтральных частиц, десорбируемых с поверхности тела при её нагреве (т. е. при термодесорбции). Для регистрации десорбируемых частиц применяют ионизационные манометры и масс-спектрометры. Последние позволяют регистрировать до  $10^{-5}$  от адсорбированного монослоя (при площади поверхности 1 см<sup>2</sup>). В качестве адсорбентов обычно используют грани монокристаллов, текстурированные ленты и поликристаллич. нити. Для получения параметров термодесорбции применяют программируанный нагрев. Т. с. используется для определения концентрации адсорбированных частиц, энергии связи адсорбированных частиц с подложкой и друг. с другом, а также для анализа фазовых переходов и хим. превращений в адсорбированных слоях. Десорбируемые радикалы могут вступать в реакции с газами, адсорбированными на внутр. стенках прибора, и вызывать десорбцию вторичных частиц, искажающую результаты анализа. Для подавления этих нежелательных эффектов стенки прибора покрывают пленкой активного вещества (при темп-ре жидкого азота), способного связывать попадающие на стенки частицы (режим «чёрной» камеры).

Лит.: Агеев В. Н., Адсорбционно-десорбционные процессы на поверхности твёрдого тела, «Поверхность. Физика, химия, механика», 1984, в. 3, с. 5. В. Н. Агеев.

**ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ**—удаление атомов, молекул и радикалов с поверхности твёрдого тела при его нагревании. Связь частицы с поверхностью разрывается в результате термич. возбуждения, и десорбция происходит в условиях термич. равновесия с подложкой. Поэтому десорбируемые частицы имеют максвелловское распределение по кинетич. энергиям с темп-рай. равной темп-ре подложки, и зависимость скорости десорбции от темп-ры определяется энергией связи частиц с поверхностью. Частный случай Т.—поверхностная ионизация, при к-рой эмиссия положит. или отрицат. ионов возникает в процессе изоэнергетич. обмена электронами между десорбирующими частицами и подложкой.

Лит.: Агеев В. Н., Зандберг Э. Я., Адсорбционно-десорбционные процессы на поверхности твёрдого тела, «Вестник АН СССР», 1985, № 12, с. 17. В. Н. Агеев.

**ТЕРМОДИНАМИКА**—наука о наиболее общих тепловых свойствах макроскопич. тел. Термодинамич. подход не требует привлечения упрощённых моделей рассматриваемых явлений, поэтому выводы Т. имеют универсальный характер.

**История развития термодинамики.** Зарождение Т. как науки связано с именем Г. Галилея (G. Galilei), к-рый ввёл понятие температуры и сконструировал первый прибор, реагирующий на изменения темп-ры окружающей среды (1597). К. Ренальдини (C. Renaldini) предложил градуировать термометр по реперным точкам. Г. Д. Фаренгейт (G. D. Fahrenheit, 1714), Р. Реомюр (R. Reamur, 1730) и А. Цельсиус (A. Celsius, 1742) создали температурные шкалы в соответствии с этим принципом. В результате работ Г. В. Рихмана (1744) формируется понятие теплоты.